

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2001年4月26日 (26.04.2001)

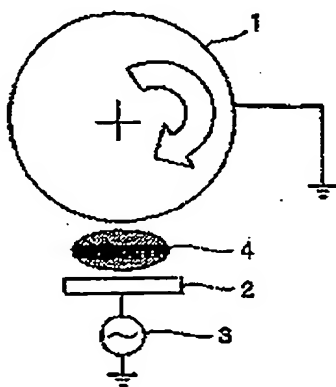
PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/29914 A1

- (51) 国際特許分類: H01M 4/02, 4/04, 4/38, 10/40
(21) 国際出願番号: PCT/JP00-07300
(22) 国際出願日: 2000年10月20日 (20.10.2000)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願平 11/301646 1999年10月22日 (22.10.1999) JP
特願平 11/301679 1999年10月22日 (22.10.1999) JP
特願平 11/365306 1999年12月22日 (22.12.1999) JP
特願2000/3644 2000年1月12日 (12.01.2000) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三洋電機株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 Osaka (JP).
(72) 発明者: および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 池田博昭 (IKEDA, Hiroaki) [JP/JP], 堂本洋一 (DOMOTO, Yoichi) [JP/JP], 八木弘雅 (YAGI, Hiromasa) [JP/JP], 津井久樹 (TSUJII, Hisaki) [JP/JP], 藤本正久 (FUJIMOTO, Masahisa) [JP/JP], 藤谷 伸 (FUJITANI, Shin) [JP/JP].
(74) 代理人: 日次 誠, 外 (METSUGI, Makoto et al.); 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1丁目6番5号 西村ビル Osaka (JP).
(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BI, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
添付公開書類:
— 国際調査報告書
2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRODE FOR LITHIUM SECONDARY CELL

(54) 発明の名称: リチウム二次電池用電極の製造方法



(57) Abstract: A method for producing an electrode for a lithium secondary cell in which an active material thin film made of an active material that can be alloyed with lithium is formed on a current collector made of a metal that is not alloyed with lithium by a technique of forming a thin film by supplying a material of vapor phase, characterized in that the active material thin film is formed at a temperature at which a mixture layer where a component of the current collector is diffused is formed in the active material thin film near the interface with the current collector.

WO 01/29914 A1

{続きあり}